

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ(ภาษาไทย).....	ก
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ).....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย.....	8
1.3 ขอบเขตของเบื้องต้น.....	9
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	9
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	9
1.6 การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์.....	10
2 ปรีทศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
2.1 กระบวนการลิโธกราฟี.....	11
2.2 กระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์.....	13
2.3 การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์เพื่อใช้ในกระบวนการลิโธกราฟี ด้วยรังสีเอ็กซ์.....	15
3 ระบบลำเลียงแสง	19
4 การลิโธกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์	25
4.1 กระบวนการลิโธกราฟี.....	25
4.2 การออกแบบหลอดฉาย.....	28
4.3 การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์.....	30

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

4.3.1	การเตรียมชิ้นงานสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์.....	31
4.3.2	การเคลือบสารไวแสงลงบนหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์.....	33
4.3.3	การถ่ายทอดลวดลายต้นแบบโดยกระบวนการลิโธกราฟฟี ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต.....	35
4.3.4	การล้างฟิล์มไวแสงบาง.....	36
4.3.5	การเติมวัสดุอุดกั้นรังสีเอ็กซ์ลงบนหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์.....	38
4.4	การเตรียมชิ้นงานและเคลือบสารไวแสง.....	43
4.5	การฉายรังสีเอ็กซ์ลงบนชิ้นงาน.....	45
4.6	การล้างสารไวแสง (Developing).....	51
5	การสร้างชิ้นงานด้วยโลหะและการผลิตซ้ำ.....	54
5.1	หลักการสร้างชิ้นงานด้วยโลหะ.....	54
5.2	การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า.....	56
5.3	การสร้างแม่พิมพ์ในการผลิตซ้ำ.....	67
6	การนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้งาน.....	72
6.1	ตัวตรวจรู้ความเร่ง.....	72
6.2	กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความเร่ง.....	74
6.3	การสร้างก้อนมวล (proof mass) ลงบนตัวชิพ.....	80
7	สรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	89
7.1	สรุปงานวิจัย.....	89
7.2	ข้อเสนอแนะ.....	90
	รายงานอ้างอิง.....	91
	ภาคผนวก	
	ภาคผนวก ก. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่.....	97
	ประวัติผู้เขียน.....	98

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1	เปรียบเทียบเวลาในการฉายรังสีเอ็กซ์บนชิ้นงานระหว่างสารไวแสง PMMA และ SU-8 ที่ความหนาของฟิล์มไวแสงต่าง ๆ.....15
4.1	ค่า Contrast เปรียบเทียบระหว่างการใช้เงินและทองคำความหนาต่าง ๆ เมื่อฉายลงบนสารไวแสงความหนา 500 ไมโครเมตร ที่กระแส ในวงกักเก็บอิเล็กตรอนเท่ากับ 40 mA.....48

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1	หลักการในการเกิดเงาบนชิ้นงานของกระบวนการลิโธกราฟีด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต.....3
1.2	หลักการในการเกิดเงาบนชิ้นงานของกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์..... 4
1.3	ลำดับขั้นตอนกระบวนการ LIGA โดยทั่วไป.....6
1.4	หน้ากากกันรังสีเอ็กซ์ที่สร้างเป็นลวดลาย SUT.....7
2.1	การติดตั้งชิ้นงานสำหรับการฉายแสง..... 12
2.2	ลักษณะและส่วนประกอบของหน้ากากกันแสง..... 13
2.3	ลำดับอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับการฉายรังสีเอ็กซ์ในกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์..... 14
2.4	ส่วนประกอบพื้นฐานของหน้ากากกันรังสีเอ็กซ์..... 16
3.1	การลำเลียงแสงจากระบบลำเลียงแสงส่วนหน้ามายังสถานีทดลองเอ็กซ์เรย์ลิโธกราฟี.....20
3.2	ลักษณะและขนาดของลำรังสีเอ็กซ์จาก BL6..... 21
3.3	การตกกระทบของรังสีเอ็กซ์ลงบนชิ้นงาน..... 21
3.4	การติดตั้งชิ้นงานลงบนเครื่องสแกนเนอร์เพื่ออาบรังสีเอ็กซ์..... 22
3.5	ห้องสุญญากาศ ที่มีระบบจับเคลื่อนชิ้นงานอยู่ภายใน..... 23
3.6	ระบบจับเคลื่อนชิ้นงานภายในห้องสุญญากาศ..... 23
4.1	การถอดแบบลวดลายด้วยกระบวนการลิโธกราฟี..... 26
4.2	ภาพตัดขวางการถอดแบบลวดลายด้วยกระบวนการลิโธกราฟี..... 26
4.3	ภาพตัดขวางการถอดแบบลวดลายด้วยกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์..... 27
4.4	ลวดลายเฟืองที่ออกแบบบนโปรแกรม LASI โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองตัวบนสุด มีขนาด 370 ไมโครเมตร..... 28
4.5	ลวดลายแท่งทดสอบที่ออกแบบบนโปรแกรม LASI โดยขนาดของแท่งแต่ละอันกว้างเท่า ๆ กัน แท่งละ 60 ไมโครเมตร..... 29

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6	ลวดลายแท่งทดสอบที่สร้างจากหมึกดำทึบแสงบนแผ่นใส.....30
4.7	ลวดลายเฟืองที่สร้างจากหมึกดำทึบแสงบนกระจกใส.....30
4.8	การติดแผ่นกราฟไฟต์บางลงบนแผ่นวงจรพิมพ์.....32
4.9	กราฟคุณสมบัติของสารไวแสง SU-8 สำหรับเบอร์ที่ให้ความหนาไม่เกิน 50 ไมโครเมตร โดยเปรียบเทียบระหว่างความเร็วในการหมุนเคลือบกับความหนาของฟิล์มที่ได้.....33
4.10	การทำงานของเครื่องหมุนเคลือบสาร (Spinner).....34
4.11	แผ่นกราฟไฟต์บางเปรียบเทียบกับบริเวณที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วกับส่วนที่เคลือบสารไวแสง SU-8 ความหนาประมาณ 25 ไมโครเมตรเรียบร้อยแล้ว.....35
4.12	การเปลี่ยนคุณสมบัติของสารไวแสงหลังการฉายแสง.....36
4.13	ลวดลายทดสอบที่ถ่ายทอดจากหน้ากากกั้นแสงอัลตราไวโอเลตมายังแผ่นกราฟไฟต์ โดยกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต.....37
4.14	ลวดลายเฟืองที่ถ่ายทอดจากหน้ากากกั้นแสงอัลตราไวโอเลตมายังแผ่นกราฟไฟต์ โดยกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต.....38
4.15	กราฟการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (ก.) กราฟการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์หลังผ่านชั้นกรองต่าง ๆ.....39 (ข.) กราฟการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์เปรียบเทียบระหว่างทองคำ, ทองแดง, นิกเกิลและเงิน.....39
4.16	การต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับการชุบเงินด้วยไฟฟ้าลงบนแผ่นกราฟไฟต์.....41
4.17	หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ลวดลายแท่งทดสอบ.....42
4.18	หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ลวดลายเฟืองขนาดต่าง ๆ.....42
4.19	กราฟคุณสมบัติของสารไวแสง SU-8 สำหรับเบอร์ที่ให้ความหนาไม่เกิน 50 ไมโครเมตร โดยเปรียบเทียบระหว่างความเร็วในการหมุนเคลือบกับความหนาของฟิล์มที่ได้.....43
4.20	แบบจำลองชิ้นงานที่เคลือบสารไวแสงหนาลงบนฐานเรียบร้อยแล้ว.....45
4.21	ลำดับขั้นในการติดตั้งชิ้นงานลงบนเครื่องแสดกนชิ้นงาน.....45
4.22	ลำดับของตัวกรองรังสีเอ็กซ์จากวงกตเก็บอเล็กตรอนก่อนจะมาตกกระทบชิ้นงาน.....46
4.23	จุดสำคัญในการวัดค่าพลังงานรวมในการฉายรังสีเอ็กซ์ลงบนสารไวแสง.....47
4.24	ผลการวัดความหนาของโลหะเงินบนหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์.....50

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.25 ค่าพลังงานสะสมบนชิ้นงาน (mA.min/cm) ที่เคลือบด้วยสารไวแสง SU-8 ความหนาต่าง ๆ ที่สามารถล้างฟิล์มแล้วได้โครงสร้างที่ดี.....	51
4.26 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) โครงสร้างทดสอบ ที่สร้างจากกระบวนการลิโทกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์.....	52
4.27 โครงสร้างเฟือง ที่สร้างจากกระบวนการลิโทกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์.....	52
5.1 ลวดลายโครงสร้างในลำดับขั้นการขึ้นรูปด้วยสารไวแสง SU-8.....	55
5.2 ชิ้นงานที่สร้างจากกระบวนการลิโทกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ (ก.) ชิ้นงานในลักษณะหลุมของสารไวแสง.....	56
(ข.) ชิ้นงานในลักษณะแท่งของสารไวแสง.....	57
5.3 ขวาคือพื้นผิวของแผ่นสแตนเลส ซ้ายคือพื้นผิวของแผ่นสแตนเลสหลังทำการพันทราย.....	58
5.4 แผนภาพแสดงการติดชิ้นงานและการต่อวงจรสำหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า.....	59
5.5 การเกิดของโลหะแบบไม่สม่ำเสมอบนชิ้นงานที่มีขนาดช่องต่างกัน.....	62
5.6 การต่อวงจรชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า.....	63
5.7 การดูฟองอากาศออกจากชิ้นงานด้วยเครื่องดูอากาศ.....	64
5.8 ภาพชิ้นงานที่เป็น โครงสร้างของโลหะนิกเกิล.....	66
5.9 เศษสารไวแสงที่อยู่บริเวณซอกของโครงสร้าง.....	67
5.10 แนวคิดการผลิตซ้ำชิ้นงาน.....	68
5.11 กระบวนการผลิตซ้ำชิ้นงาน โดยการถอดแบบด้วยพอลิเมอร์ PDMS.....	69
5.12 โครงสร้างที่จะทำการทดสอบการถอดแบบด้วย PDMS.....	70
5.13 แม่พิมพ์ที่สร้างจากพอลิเมอร์ PDMS.....	71
6.1 ลักษณะโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความเร่ง (ก.) ตัวตรวจรู้ความเร่งแบบเพียโซรีซิสทีฟ.....	73
(ข.) ตัวตรวจรู้ความเร่งแบบคาปาซิทีฟ.....	73
6.2 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความเร่ง (ก.) แบบวัดความเร่งในแนวตั้งฉากกับฐานรอง.....	75
(ข.) แบบวัดความเร่งในแนวนอนกับฐานรอง.....	75

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
6.3	โครงสร้างตัวตรวจรู้ความเร่งแบบวัดความเร่งในแนวตั้งฉากกับฐานรอง.....78
6.4	ภาคตัดขวางของลำดับขั้นกระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความเร่งด้วยกระบวนการ PolyMUMPs โดยใช้โปรแกรม L-edit ในการออกแบบ.....79
6.5	ตัวตรวจรู้ความเร่งหลังจากส่งสร้างด้วยกระบวนการ PolyMUMPs.....80
6.6	ขั้นตอนการสร้างก้อนมวลรับความเร่งลงบนชิพด้วยกระบวนการลิโธกราฟีด้วย แสงอัลตราไวโอเล็ตคู่กับสารไวแสงชนิดบวก AZP4620.....81
6.7	ลักษณะของหน้ากากเมื่อทับบนชิ้นงาน.....82
6.8	กระบวนการสร้างก้อนมวลรับความเร่ง ด้วยกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์.....83
6.9	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ของก้อนมวล SU-8 ต้นแบบ.....84
6.10	กระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการถอดแบบชิ้นงานด้วยพอลิเมอร์ PDMS.....85
6.11	แม่พิมพ์ของก้อนมวลที่สร้างจากพอลิเมอร์ PDMS.....86
6.12	ขั้นตอนการสร้างก้อนมวลลงบนชิพด้วยแม่พิมพ์ PDMS.....87
6.13	ตัวตรวจรู้ความเร่งที่มีก้อนมวลรับความเร่ง ที่สร้างจากกระบวนการการถอดแบบ ด้วยแม่พิมพ์ PDMS สูงประมาณ 500 ไมโครเมตร.....88

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

k	คือ ค่าคงที่ของเครื่องเคลือบหมุน (ปกติมีค่า 80 – 100)
p	คือ อัตราส่วนของสารไวแสงที่ผสมกับสารประกอบ (%)
w	คือ ความเร็วในการหมุนเคลือบ (rpm/1000)
$C(d)$	คือ ค่า Contrast สำหรับสารไวแสงหนาเท่ากับ d
$E_1(d)$	คือ ค่าพลังงาน Top dose สำหรับสารไวแสงหนาเท่ากับ d
$E_0(d)$	คือ ค่าพลังงาน Bottom dose สำหรับสารไวแสงหนาเท่ากับ d
M	คือ วัสดุที่เกิดปฏิกิริยา
M^{n+}	คือ จำนวนไอออนของวัสดุที่เกิดปฏิกิริยา
ne^-	คือ จำนวนอิเล็กตรอนในการเกิดปฏิกิริยา
ω	คือ มวลของโลหะที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบหรือที่หลุดออกจากขั้วบวกในหน่วยกรัม (g)
A_ω	คือ มวลอะตอม (atomic weight) ของโลหะที่ชุบ
n_{el}	คือ จำนวนอิเล็กตรอนในการเกิดปฏิกิริยา
F	คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ (Faraday's constant) มีค่าเท่ากับ 96,487 (คูลอมบ์ต่อ โมล)
I	คือ กระแสที่ไหลผ่านสารละลายในภาชนะ (mA)
t	คือ เวลาในการชุบโลหะ (วินาที)
η	คือ ประสิทธิภาพในการชุบโลหะ (Plating efficiency)
ρ	คือ ความหนาแน่นของโลหะ
A	คือ พื้นที่การชุบโลหะ
h	คือ ความสูงของโลหะก่อตัวขึ้น
J	คือ ความหนาแน่นกระแส (A/cm^2)